

FEATURES

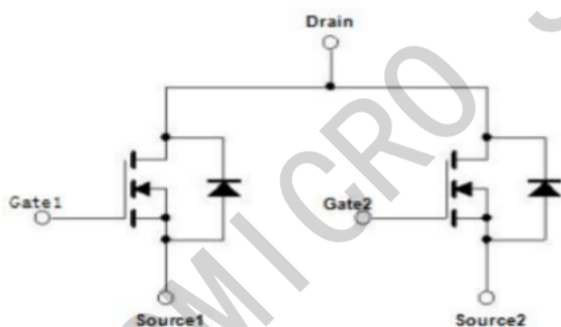
- Die in 8" Wafer Form
- 20V, 6A*, N-channel
- Sampling Tested at Probe

APPLICATION

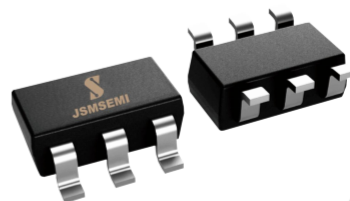
- Portable Equipment
- Battery Powered System

特点

- 专有的先进平面技术
- 高密度超低电阻设计
- 大功率、大电流应用
- 理想的锂电池应用
- 封装形式: SOT23-6, TSSOP8

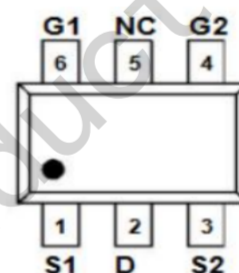


N-Channel MOSFET



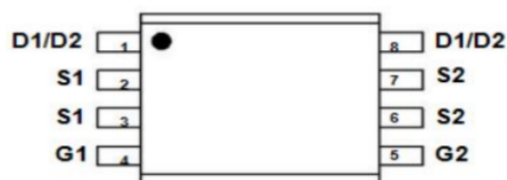
SOT23-6

8205S/SOT-23-6



TSSOP-8

8205A/TSSOP-8



最大额定值和热特性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$, 除非另有说明。)

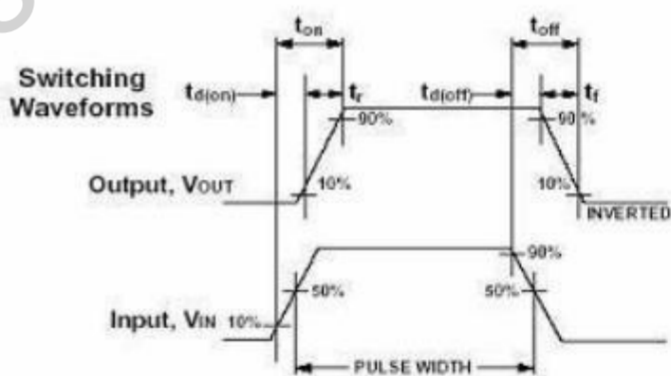
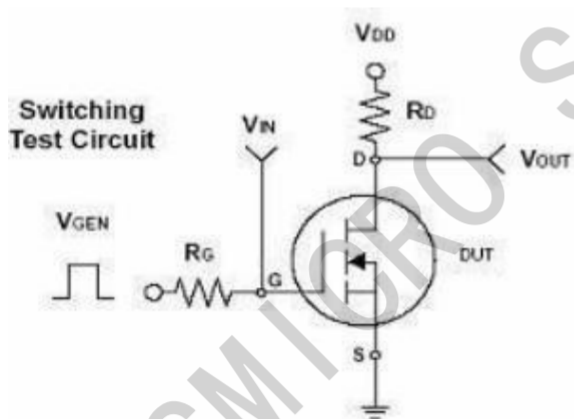
参数		符号	值	单位
漏源电压		V_{DS}	20	V
栅源电压		V_{GS}	± 12	
漏极电流		I_D	6	A
漏极脉冲电流		I_{DM}	20	
最大功耗	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	P_D	2	W
	$T_A = 75^{\circ}\text{C}$		1.3	
工作结温和存储温度范围		T_J, T_{stg}	-55 to 150	$^{\circ}\text{C}$
结环热阻 (PCB 安装)		$R_{\theta JA}$	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。贴片时回流焊炉温请控制在 265°C 以下。

电特性

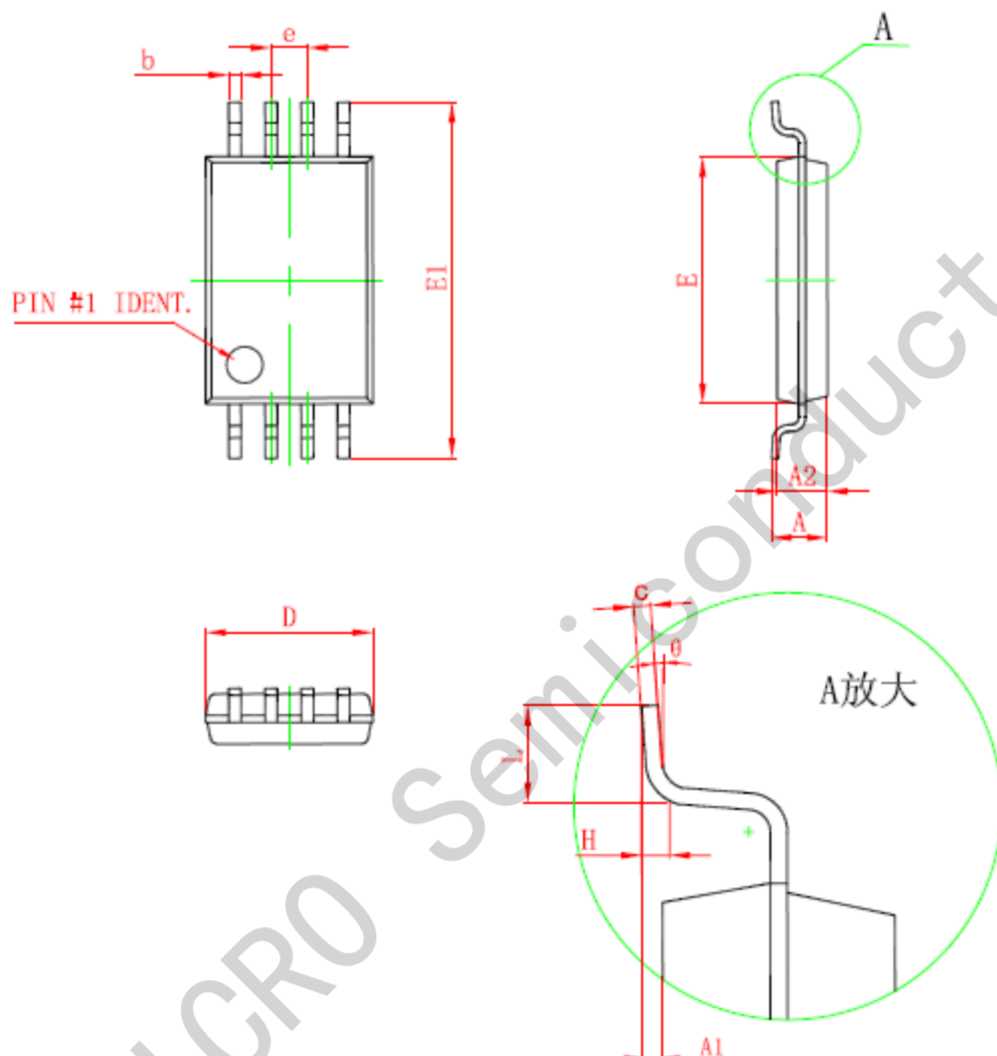
参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静电						
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	20	--	--	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 1A$	--	--	19.5	$m\Omega$
		$V_{GS} = 2.5V, I_D = 1A$	--	--	30	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	0.55	--	0.95	V
栅源短路时漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS} = 20V, V_{GS} = 0V$	--	--	1	μA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 12V, I_D = 0\mu A$	--	--	± 100	nA

动态						
总栅极电荷	Q _g	V _{DS} = 10V, I _D = 6A V _{GS} = 4.5V		6.1	8.11	nC
栅源电荷	Q _{gs}			1.5	2.13	
栅漏电荷	Q _{gd}			1.2	1.74	
延迟时间 (On)	t _{d(on)}	V _{DD} = 10V, I _D = 6A I _D = 1A, V _{GS} = 4.5V		10.4	20.8	ns
上升时间 (On)	t _r			4.4	8.8	
延迟时间 (Off)	t _{d(off)}			27.36	54.72	
下降时间 (Off)	t _f			4.16	8.32	
输入电容	C _{iss}	V _{DS} = 8V, V _{GS} = 0V f=1.0MHz	--	520.3	--	pF
输出电容	C _{oss}		--	95.48	--	
反向传输电容	C _{rss}		--	72.69	--	
漏源二极管						
二极管最大正向电流	I _s	--	--	--	1.7	A
二极管正向电压	V _{SD}	I _s = 1.7A, V _{GS} = 0V	--	--	1.2	V



Package Information

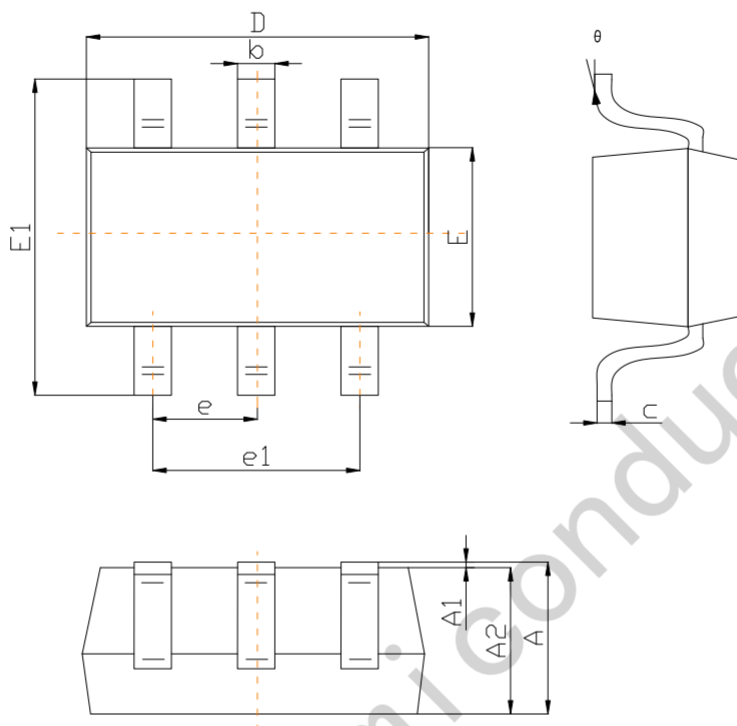
TSSOP-8



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	4.300	4.500	0.169	0.177
b	0.190	0.300	0.007	0.012
c	0.090	0.200	0.004	0.008
E1	6.250	6.550	0.246	0.258
A		1.100		0.043
A2	0.800	1.000	0.031	0.039
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
e	0.65 (BSC)		0.026 (BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.028
H	0.25 (TYP)		0.01 (TYP)	
θ	1°	7°	1°	7°

Package Information

SOT23-6



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100		0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
	0°	8°	0°	8°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFETs](#) category:

Click to view products by [JSMSEMI](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [NTNS3A92PZT5G](#) [IRFD120](#) [2SK2464-TL-E](#) [2SK3818-DL-E](#) [2SJ277-DL-E](#) [2SK2267\(Q\)](#) [MIC4420CM-TR](#) [IRFS350](#) [IPS70R2K0CEAKMA1](#) [AON6932A](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#) [SCM040600](#) [NTE2384](#) [2N7000TA](#) [DMN2080UCB4-7](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [IRF40H233XTMA1](#) [STU5N65M6](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [STU7N60DM2](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [DMN2990UFB-7B](#) [2N7002W-G](#) [MCQ7328-TP](#) [IPB45P03P4L11ATMA2](#) [BXP4N65F](#) [BXP2N20L](#) [BXP2N65D](#) [TSM60NB380CP](#) [ROG](#) [SLF10N65ABV2](#) [IRF9395MTRPBF](#) [FCMT080N65S3](#) [NTD5C632NLT4G](#) [NTMFS0D55N03CGT1G](#) [NTMFS1D15N03CGT1G](#) [NTMTS0D4N04CTXG](#) [NTMYS2D1N04CLTWG](#) [NVD360N65S3T4G](#) [NVD5C464NLT4G](#) [NVMTS001N06CLTXG](#) [NVMTS1D1N04CTXG](#)